

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年4月20日(2006.4.20)

【公開番号】特開2004-47989(P2004-47989A)

【公開日】平成16年2月12日(2004.2.12)

【年通号数】公開・登録公報2004-006

【出願番号】特願2003-169817(P2003-169817)

【国際特許分類】

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

G 09 F 9/30 (2006.01)

H 01 L 21/20 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 1 2 D

G 09 F 9/30 3 3 8

H 01 L 21/20

H 05 B 33/14 A

H 01 L 29/78 6 2 7 G

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月2日(2006.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

レーザ光の照射を走査することにより結晶化された半導体を用いて形成された画素用駆動トランジスタを具備する画素がマトリクス状に複数設けられた半導体装置であって、

前記画素用駆動トランジスタはチャネル形成領域を有し、

前記レーザ光の走査方向において、前記チャネル形成領域の長さは、2つの画素にまたがっていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

レーザ光の照射を走査することにより結晶化された半導体を用いて形成された画素用駆動トランジスタを具備する画素がマトリクス状に複数設けられた半導体装置であって、

前記画素用駆動トランジスタはチャネル形成領域を有し、

前記レーザ光の走査方向において、それぞれの画素の長さは一定であり、前記チャネル形成領域の長さは、2つの画素にまたがっていることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項1又は請求項2において、

前記レーザ光の走査方向における前記チャネル形成領域の長さは、前記画素の長さよりも長く、且つ前記画素の長さの2倍の長さよりも短いことを特徴とする半導体装置。

【請求項4】

レーザ光の照射を走査することにより結晶化された半導体を用いて形成された画素用駆動トランジスタを具備する画素がマトリクス状に複数設けられた半導体装置であって、

前記画素用駆動トランジスタはチャネル形成領域を有し、

前記レーザ光の走査方向において、前記チャネル形成領域の長さは、前記チャネル形成

領域の長さは、3つの画素にまたがっていることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】

レーザ光の照射を走査することにより結晶化された半導体を用いて形成された画素用駆動トランジスタを具備する画素がマトリクス状に複数設けられた半導体装置であって、

前記画素用駆動トランジスタはチャネル形成領域を有し、

前記レーザ光の走査方向において、それぞれの画素の長さは一定であり、前記チャネル形成領域の長さは、前記チャネル形成領域の長さは、3つの画素にまたがっていることを特徴とする半導体装置。

【請求項6】

請求項4又は請求項5において、

前記レーザ光の走査方向における前記チャネル形成領域の長さは、前記画素の長さの2倍の長さよりも長く、且つ前記画素の長さの3倍の長さよりも短いことを特徴とする半導体装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置